

# KT502A, KT502B, KT502B, KT502Г, KT502Д, KT502E

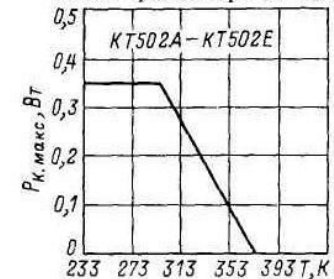
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* универсальные низкочастотные маломощные

Предназначены для работы в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах

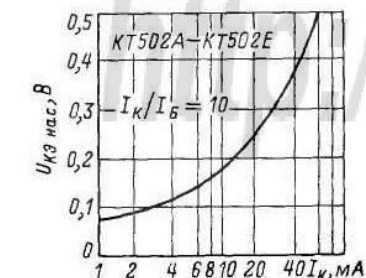
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами

Обозначение типа приводится на этикетке

Масса транзистора не более 0,3 г



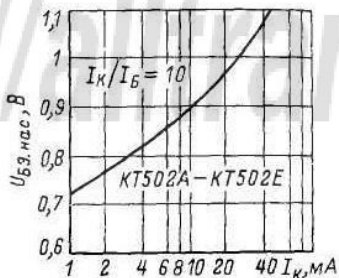
Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры.



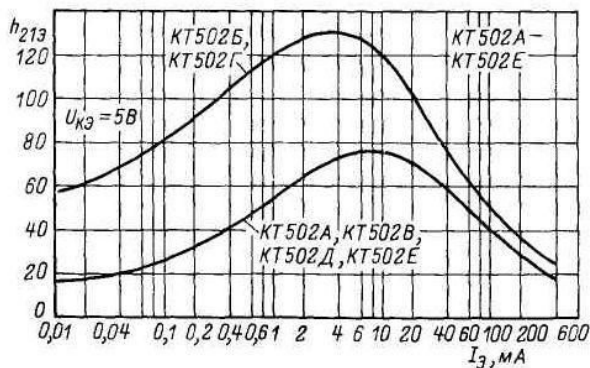
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.

**Примечание.** Пайку выводов разрешается производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. При пайке жатого паяльника должно быть заземлено

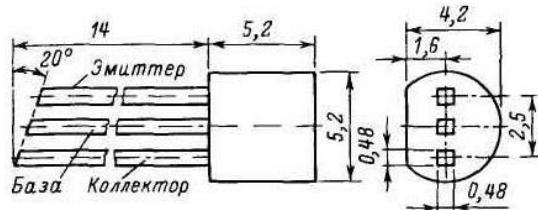
Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5–2 мм, при этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



## Электрические параметры

Граничное напряжение при  $I_э = 10$  мА,  $\tau_{и} \leq 30$  мкс,  $Q \geq 100$  не менее

|                          |      |
|--------------------------|------|
| KT502A, KT502Б . . . . . | 25 В |
| KT502B, KT502Г . . . . . | 40 В |
| KT502Д . . . . .         | 60 В |
| KT502E . . . . .         | 80 В |

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при  $I_к = 10$  мА,  $I_б = 1$  мА не более . . . . . 0,6 В  
типое значение . . . . . 0,15\* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_к = 10$  мА,  $I_б = 1$  мА не более . . . . . 1,2 В  
типое значение . . . . . 0,8\* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при  $U_{кэ} = 5$  В,  $I_э = 10$  мА  
KT502A, KT502B, KT502Д, KT502E . . . . . 40 – 120  
KT502Б, KT502Г . . . . . 80 – 240

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при  $U_{кэ} = 5$  В,  $I_э = 3$  мА,  $f = 1$  МГц не менее . . . . . 5 МГц

Емкость коллекторного перехода при  $U_{кб} = 5$  В  $f = 465$  кГц не более . . . . . 20 пФ

Обратный ток коллектора при  $U_{кб} = U_{кб макс}$  не более . . . . . 1 мкА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при  $T = 233 - 358$  К . . . . . 40 В  
KT502A, KT502Б . . . . . 40 В  
KT502B, KT502Г . . . . . 60 В  
KT502Д . . . . . 80 В  
KT502E . . . . . 80 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при  $T = 233 - 358$  К . . . . . 5 В

Постоянный ток коллектора при  $T = 233 - 358$  В . . . . . 0,15 А

Импульсный ток коллектора при  $\tau_{и} \leq 10$  мс,  $Q \geq 100$ ,  $T = 233 - 358$  К . . . . . 0,35 А

Постоянный ток базы при  $T = 233 - 358$  В . . . . . 0,1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при  $T = 233 - 298$  К . . . . . 0,35 Вт

Температура перехода . . . . . 398 К

Температура окружающей среды . . . . . От 233 до 358 К